DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

15412707

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 11251067 A2 19990917 <No. of Patents: 008 >

ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT (English)

Patent Assignee: KIDO JUNJI; AIMESU KK

Author (Inventor): KIDO JUNJI; MIZUKAMI TOKIO; ENDO JUN

IPC: *H05B-033/22; H05B-033/10; H05B-033/14 CA Abstract No: *131(16)221052U; 131(16)221052U

Derwent WPI Acc No: *C 99-543145; Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind :	Date A	pplic No Kind	Date		
CN 1236289	Α	19991124	CN 99103210	Α	19990302	
EP 948063	A2	19991006	EP 99103682	Α	19990225	
EP 948063	A3	20000823	EP 99103682	Α	19990225	
JP 11251067	A2	19990917	JP 9849771	Α	19980302 (BASIC))
US 200100466	511 AA	20011129	US 257778	Α	19990225	
US 6423429	BA	20020723	US 257778	Α	19990225	
US 6423429	BE	3 20020723	US 257778	Α	19990225	
TW 411725	В	20001111	TW 88102990	Α	19990226	

Priority Data (No,Kind,Date): JP 9849771 A 19980302 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 06309469

ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

PUB. NO.:

11-251067 [JP 11251067 A]

PUBLISHED:

September 17, 1999 (19990917)

INVENTOR(s): KIDO JUNJI

MIZUKAMI TOKIO

ENDO JUN

APPLICANT(s): KIDO JUNJI

AIMESU KK

APPL. NO.:

10-049771 [JP 9849771]

FILED:

March 02, 1998 (19980302)

INTL CLASS: H05B-033/22; H05B-033/10; H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To allow a low driving voltage regardless of the work function of a negative electrode material by doping an electron accepting compound having the property to oxidize the organic compound constituting an organic layer to the organic compound of a portion kept in contact with a positive electrode as an electron accepting dopant in vacuum by the co-deposition method.

SOLUTION: A glass substrate 1 is coated with ITO having the sheet resistance of 25 Ω/(square) as a positive transparent electrode 2, αNPD having a positive hole transportation property and ferric chloride are co-deposited into a film with the thickness of 100 & angst; at the mole ratio of 1:2 at the deposition speed of 3 & angst;/sec under 10-6 Torr to form a positive hole injection layer 3 on the positive transparent electrode 2. The α NPD is vacuum-deposited to the thickness of 500 Å on the same condition as a positive hole transportation layer 4 on the positive hole injection layer 3. Tris (8-quinolinolate) aluminum complex is formed at the thickness of 700 & angst; on the same condition as a luminescence layer 5. Aluminum is deposited at the thickness of 1000 Å at the deposition speed of 15 Å/sec as a back electrode 6 serving as a negative electrode. The maximum luminance of 4700 cd/m2 is obtained at 12 V.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-251067

(43)公開日 平成11年(1999)9月17日

(51) Int. CI. ⁶ H05B 33/22 33/10 33/14	識別記号	F I H05B 33/22 33/10 33/14	1		
		審查請求	未請求 請求項の数6 〇L (全7頁)		
(21)出顧番号	特願平10-49771	(71)出顧人	597011728 城戸 淳二		
(22) 出願日	平成10年(1998) 3月2日	(71)出願人	奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3 593191350 株式会社アイメス 神奈川県藤沢市桐原町3番地		
		(72)発明者	城戸 淳二 奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3		
		(72) 発明者	水上 時雄 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア イメス内		
		(74)代理人	弁理士 三浦 邦夫		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセント素子

(57)【要約】

【目的】 正孔輸送性有機化合物にIT〇電極から正孔 を注入する際のエネルギー障壁を低下させ、陽極電極の 仕事関数に関わらず、低駆動電圧である有機エレクトロルミネッセント素子を提供すること。

【構成】 陽極電極2に接する有機層3に電子受容性ドーパントとして機能する化合物を共蒸着の手法によりドーピングし、陽極電極2から有機層3への正孔注入障壁を小さくし、駆動電圧を低下させた有機エレクトロルミネッセント素子。

6	陰極電極
5	発光層
4 ———	正孔輸送曆
3	正孔注入層 (有機層)
2	陽極透明電極(ITO)
l	透明基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する陽極電極と陰極電極の間に、有 機化合物から構成される少なくとも一層の発光層を有す る有機エレクトロルミネッセント素子において、上記陽 極電極に接する部分の有機層に、有機層を構成する有機 化合物を酸化しうる性質を有する電子受容性化合物を電 子受容性ドーパントとして真空中で共蒸着の手法により ドーピングしたことを特徴とする有機エレクトロルミネ ッセント素子。

1

【請求項2】 請求項1記載の素子において、上記電子 10 受容性ドーパントが無機化合物からなる有機エレクトロ ルミネッセント素子。

【請求項3】 請求項1および2記載の素子において、 上記電子受容性ドーパントが塩化第二鉄、塩化アルミニ ウム、塩化ガリウム、塩化インジウム、五塩化アンチモ ン等のルイス酸化合物からなる有機エレクトロルミネッ セント素子。

【請求項4】 請求項1記載の素子において、上記電子 受容性ドーパントが有機化合物からなる有機エレクトロ ルミネッセント素子。

【請求項5】 請求項1記載の素子において、電子受容 性化合物のモル比率が、有機層を構成する有機化合物に 対して、0.1~10である有機エレクトロルミネッセ ント素子。

【請求項6】 請求項1記載の素子において、電極間の 有機層のトータル膜厚が2000Åを超える厚膜の有機 エレクトロルミネッセント素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、平面光源や表示素子に利用され 30 る有機エレクトロルミネッセント素子(以下、有機EL 素子) に関するものである。

[0002]

【従来の技術およびその問題点】発光層が有機化合物か ら構成される有機エレクトロルミネッセント素子は、低 電圧駆動の大面積表示素子を実現するものとして注目さ れている。Tangらは素子の高効率化のため、キャリア輸 送性の異なる有機化合物を積層し、正孔と電子がそれぞ れ陽極、陰極よりパランスよく注入される構造とし、し かも有機層の膜厚を2000A以下とすることで、10V 以下 40 の印加電圧で1000cd/m²と外部量子効率1%の実用 化に十分な高輝度、高効率を得ることに成功した(Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987).)。この高効率素子にお いて、Tangらは基本的に絶縁物とみなされる有機化合物 に対して、金属電極から電子を注入する際に問題となる エネルギー障壁を低下させるため、仕事関数の小さレMg (マグネシウム)を使用した。その際、Mgは酸化しやす く、不安定であるのと、有機表面への接着性に乏しいの で比較的安定で、しかも有機表面に密着性の良いAg

への正孔注入においては、光の面上の取出の必要性か ら、陽極として透明な酸化物電極として【T〇(】nd ium Tin Oxide) が用いられることが多 く、この電極の仕事関数が~5.0eVと比較的大きいこ とから接触する正孔輸送性有機物とのオーミックに近い コンタクトを実現しているのは偶然の幸運といって良 い。Tangらは陽極界面のコンタクトを更に改善して素子 の低電圧化を実現するために200人以下の膜厚の銅フ タロシアニン(以下CuPc) を陽極と正孔輸送性有機 物との間に挿入した。

【0003】パイオニア株式会社のグループは大阪大学 の城田らの提案したスターバースト型のアリールアミン 化合物を用いることで同様の効果を得ている。両方とも 仕事関数が1TOよりも小さく、また正孔電荷の移動度 も比較的大きいという特徴があり低電圧化とともに界面 のコンタクト改善によって、連続駆動時の安定性にも改 善がみられる。これらの蒸着系の素子の他に高分子を溶 液からスピンコート等の塗布法によって成膜する系では 電子受容性化合物を正孔輸送性高分子に予め分散して塗 20 布溶液とするものがある。Partridge はポリビニルカル バゾール(以下PVK)のジクロロメタン溶液中に電子 受容性化合物として五塩化アンチモン(以下SbС1。

)を分散しPVKのみの膜では実現しないオーミック 電流を観測した(POLYMER, 1983, Vol 24, Jun e)。この場合SbCl。はルイス酸としてPVKのカ ルバゾールペンダントを酸化させラジカルカチオンを生 成させている、と考えられる。Partridge の使用したS bCl。は室温で液体であり、空気中の水分と反応して ヒュームを発生するほど反応性の高いルイス酸化合物で あるが不活性雰囲気のグローブボックス中でPVKと反 応させると安定な錯体を形成し、大気中でも比較的安定 に成膜が可能となる。したがってこの点ではITOから の正孔注入層の成膜法として合理的な考え方といえる が、最近の有機EL素子の高効率化は蒸着法を採用した クロスコンタミネーションのない高純度成膜に因るとこ ろが多く、Partridge の方法をそのまま応用しても溶媒 残渣や成膜材料中の不純物等の影響で素子の安定駆動に 疑問が残る。

[0004]

【発明の目的】本発明は、以上の事情に鑑みてなされた ものであり、正孔輸送性有機層にIT〇透明電極から正 孔を注人する際のエネルギー障壁を低下させ、陽極材料 の仕事関数に関わらず低駆動電圧を実現することを目的 とする。

[0005]

【発明の概要】本発明は、陽極に接する有機層を電子受 容性ドーパントとして機能する化合物で共蒸着の手法に よってドーピングすると、陽極から該有機層への正孔注 入障壁が小さくなり、駆動電圧を低下させることができ (銀)と共蒸着により合金化して用いた。また、有機物 50 ることを見い出して完成されたものである。すなわち、

本発明の有機EL素子は、対向する陽極電極と陰極電極 の間に、有機化合物から構成される少なくとも一層の発 光層を有する有機UL素子において、上記陽極電極に接す る部分の有機層に、有機層を構成する有機化合物を酸化 しうる性質を有する電子受容性化合物を電子受容性ドー パントとして真空中で共蒸着の手法によりドーピングし たことを特徴としている。有機EL素子では陽極から基 本的に絶縁物である有機層への正孔注入過程は、陽極表 面での有機化合物の酸化、すなわちラジカルカチオン状 態の形成である (Phys. Rev.Lett., 14, 229 (1965))。 本発明の素子においては、予め有機化合物の酸化剤とな りうる電子受容性ドーパント物質である化合物を陽極に 接触する有機層中にドーピングする事により、陽極電極 からの正孔注入に際するエネルギー障壁を低下させるこ とができる。ドーピングした有機層中には、すでにドー パントにより酸化された状態(すなわち電子を供与した 状態)の分子が存在するので、正孔注入エネルギー障壁 が小さく、従来の有機EL素子と比べて駆動電圧を低下

機化合物を酸化する性質を有すれば、無機化合物でも有 機化合物でも使用でき、具体的には、塩化第二鉄や、塩 化アルミニウム、塩化ガリウム、塩化インジウム、五塩 化アンチモン等のルイス酸化合物を好適に用いることが 出来、有機化合物の場合はトリニトロフルオレノン等の 電子受容性化合物をドーパントとして好適に使用でき る。該化合物を共蒸着によって有機層にドーピングする 手法において、塩化第二鉄や、塩化インジウム等の比較 的飽和蒸気圧の低い化合物はルツボに入れて通常の抵抗 加熱法によって蒸着可能であるが、常温でも蒸気圧が高 30 く真空装置内の気圧を所定の真空度以下に保てない場合 は、ニードルバルプやマスフローコントローラーのよう にオリフィス(開口径)をコントロールして蒸気圧を制 御したり試料保持部分を独立に温度制御可能な構造にし て冷却によって蒸気圧をコントロールしても良い。この ようにして成膜された有機層の厚さは、特に制限はない が5A以上とすることが好まい。この有機層は無電場の 状態でも有機物がラジカルカチオンの状態で存在し、内 部電荷として振る舞えるので膜厚には特に制限は無く、 厚膜にしても素子の電圧上昇をもたらすことが無いので 40 アニン、キナクリドン、ルプレン等およびそれらの誘導 電極間の距離を通常の有機EL素子の場合よりも長く設 定することにより短絡の危険性を大幅に軽減する手段と しても有用である。従って、電極間の有機層のトータル 膜厚を2000A以上にすることも可能である。ドーピング した有機層中のドーパント濃度は特に限定されないが、 有機分子とドーパント分子のモル比率が、有機分子:ド ーパント分子=1:0.1~1:10の範囲であること が好ましい。ドーパント分子の比率が0.1未満ではド ーパントにより酸化された分子(以下、酸化分子)の濃 度が低すぎドーピングの効果が小さく、10倍を越える 50 ウム、トリス(5-メチル-8- キノリノラト)アルミニウ

と、膜中のドーパント濃度が有機分子濃度をはるかに超 え、酸化分子の膜中濃度が極端に低下するので、ドーピ ングの効果も下がる。

[0007]

【発明の実施形態】図1は、本発明による有機EL 素子 の一実施形態を示す模式図である。ガラス基板(透明基 板) 1上には、順に、陽極電極を構成する透明電極2、 電子受容性化合物でドーピングされた正孔注入層(有機 層) 3、正孔輸送性を有する正孔輸送層4、発光層5、 10 および陰極となる背面電極6を積層してなっている。こ れらの要素(層)のうち、ガラス基板(透明基板)1、 透明電極2、正孔輸送層4、発光層5、および陰極電極 6は周知の要素であり、正孔注入層3が本発明で提案し た特徴を有する層である。有機EL素子の具体的な積層 構成としては、この他、陽極/正孔注入層/正孔輸送層 / 発光層/電子輸送層/陰極、陽極/正孔注入層/発光 層/電子注入層/陰極、陽極/正孔注入層/正孔輸送層 /発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極、などが挙げ られるが、本発明による有機EL素子は、電子受容性化 【0006】電子受容性ドーパントは、電子受容性で有 20 合物でドーピングされた正孔注入層3 を陽極電極2 との 界面に有するものであればいかなる素子構成であっても 良い。

> 【0008】発光層、電子輸送層として使用できる有機 化合物としては、特に限定はないが、p-テルフェニルや クアテルフェニルなどの多環化合物およびそれらの誘導 体、ナフタレン、テトラセン、ピレン、コロネン、クリ セン、アントラセン、ジフェニルアントラセン、ナフタ セン、フェナントレンなどの縮合多環炭化水素化合物及 びそれらの誘導体、フェナントロリン、パソフェナント ロリン、フェナントリジン、アクリジン、キノリン、キ ノキサリン、フェナジンなどの縮合複素環化合物および それらの誘導体や、フルオレセイン、ペリレン、フタロ ベリレン、ナフタロペリレン、ベリノン、フタロベリノ ン、ナフタロペリノン、ジフェニルプタジエン、テトラ フェニルプタジエン、オキサジアゾール、アルダジン、 ピスベンゾキサゾリン、ピススチリル、ピラジン、シク ロペンタジエン、オキシン、アミノキノリン、イミン、 ジフェニルエチレン、ピニルアントラセン、ジアミノカ ルパゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシ 体などを挙げることができる。

【0009】また、特開昭63-295695 号公報、特開平8-22557 号公報、特開平8-81472 号公報、特開平5-9470号 公報、特開平5-17764 号公報に開示されている金属キレ ート錯体化合物、特に金属キレート化オキサノイド化合 物では、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム、ビス (8-キノリノラト) マグネシウム、ピス [ベンゾ (f) -8- キノリノラト] 亜鉛、ピス (2-メチル-8- キノリノ **ラト) アルミニウム、トリス(8-キノリノラト) インジ**

ム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロ-8- キ ノリノラト) ガリウム、ビス(5-クロロ-8- キノリノラ ト) カルシウムなどの8-キノリノラトあるいはその誘導 体を配位子として少なくとも一つ有する金属錯体が好適 に使用される。

【0010】特開平5-202011号公報、特開平7-179394号 公報、特開平7-278124号公報、特開平7-228579号公報に 開示されているオキサジアゾール類、特開平7-157473号 公報に開示されているトリアジン類、特開平6-203963号 ルアリーレン誘導体、特開平6-132080号公報や特開平6-88072 号公報に開示されているスチリル誘導体、特開平 6-100857号公報や特開平6-207170号公報に開示されてい るジオレフィン誘導体も発光層や、電子輸送層として好 ましい。

【0011】さらに、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチ アゾール系、ベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤も 使用でき、例えば、特開昭59-194393 号公報に開示され ているものが挙げられる。その代表例としては、2,5-ビ ス (5,7-ジ-t- ペンチル-2-ベンソオキサゾリル) -1,3, 20 4- チアゾール、4,4'- ビス(5,7-l-ペンチル-2- ベン ソオキサゾリル) スチルベン、4,4'- ピス〔5,7-ジ-(2-メチル-2- ブチル) -2- ベンゾオキサゾリル] スチ ルベン、2,5-ビス(5.7-ジ-1- ペンチル-2- ベンゾオキ サソリル) チオフェン、2,5-ピス [5-(α, α-ジメチ ルベンジル)-2-ベンゾオキサゾリル] チオフェン、2,5 -ビス [5,7-ジ- (2-メチル-2- ブチル) -2- ベンゾオ キサゾリル]-3,4- ジフェニルチオフェン、2,5-ビス (5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル) チオフェン、4,4' - ビス (2-ベンソオキサゾリル) ビフェニル、5-メチル -2- {2- [4- (5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル) フェ ニル] ビニル} ベンゾオキサゾール、2- [2-(4-クロロ フェニル) ビニル] ナフト (1,2-d)オキサゾールなどの ベンゾオキサゾール系、2,2'-(p-フェニレンジピニレ ン)-ビスペンゾチアゾールなどのペンゾチアゾール系、 2- {2- [4- (2-ベンソイミダゾリル) フェニル] ビニ ル ペンゾイミダゾール、2-[2-(4-カルボキシフェニ ル) ビニル] ベンゾイミダゾールなどのベンゾイミダゾ ール系などの蛍光増白剤が挙げられる。

【0012】ジスチリルベンゼン系化合物としては、例 40 えば欧州特許第0373582 号明細書に開示されているもの を用いることができる。その代表例としては、1,4-ビス (2- メチルスチリル) ベンゼン、1,4-ビス (3-メチル スチリル) ベンゼン、1,4-ビス(4~メチルスチリル)ベ ンゼン、ジスチリルベンゼン、1,4-ビス(2-エチルスチ リル) ベンゼン、1,4-ビス(3-エチルスチリル)ベンゼ ン、1,4-ビス(2-メチルスチリル)-2- メチルベンゼ ン、1,4-ビス(2-メチルスチリル)-2- エチルベンゼン などが挙げられる。

いるジスチリルピラジン誘導体も発光層、電子輸送層と して用いることができる。その代表例としては、2,5-ビ ス(4-メチルスチリル)ピラジン、2,5-ビス(4-エチル スチリル) ピラジン、2,5-ビス [2- (1-ナフチル) ビニ ル] ピラジン、2,5-ピス(4-メトキシスチリル)ピラジ ン、2,5-ビス [2- (4-ビフェニル) ビニル] ピラジン、 2,5-ビス [2-(1-ピレニル) ビニル] ピラジンなどが挙 げられる。

6

【0014】その他、欧州特許第388768号明細書や特開 公報に開示されているスチルベン誘導体およびジスチリ 10 平3-231970号公報に開示されているジメチリディン誘導 体を発光層、電子輸送層の材料として用いることもでき る。その代表例としては、1,4-フェニレンジメチリディ ン、4,4'- フェニレンジメチリディン、2,5-キシリレン ジメチリディン、2,6-ナフチレンジメチリディン、1,4-ピフェニレンジメチリディン、1,4-p-テレフェニレンジ メチリディン、9,10-アントラセンジイルジメチリディ ン、4,4'-(2,2-ジーィ-ブチルフェニルビニル)ビフェ ニル、4,4'-(2,2-ジフェニルピニル) ピフェニル、な ど、及びこれらの誘導体や、特開平6-49079 号公報、特 開平6-293778号公報に開示されているシラナミン誘導 体、特開平6-279322号公報、特開平6-279323号公報に開 示されている多官能スチリル化合物、特開平6-107648号 公報や特開平6-92947 号公報に開示されているオキサジ アゾール誘導体、特開平6-206865号公報に開示されてい るアントラセン化合物、特開平6-145146号公報に開示さ れているオキシネイト誘導体、特開平4-96990 号公報に 開示されているテトラフェニルプタジエン化合物、特開 平3-296595号公報に開示されている有機三官能化合物、 さらには、特開平2-191694号公報に開示されているクマ リン誘導体、特開平2-196885号公報に開示されているペ リレン誘導体、特開平2-255789号に開示されているナフ タレン誘導体、特開平2-289676号及び特開平2-88689 号 公報に開示されているフタロベリノン誘導体、特開平2-250292号公報に開示されているスチリルアミン誘導体な どが挙げられる。さらに、従来有機EL素子の作製に使 用されている公知のものを適宜用いることができる。

【0015】正孔注入層(ドービング層)、正孔輸送 層、正孔輸送性発光層として使用されるアリールアミン 化合物類としては、特に限定はないが、特開平6-25659 号公報、特開平6-203963号公報、特開平6-215874号公 報、特開平7-145116号公報、特開平7-224012号公報、特 開平7-157473号公報、特開平8-48656 号公報、特開平7-126226号公報、特開平7-188130号公報、特開平8-40995 号公報、特開平8-40996 号公報、特開平8-40997 号公 報、特開平7-126225号公報、特開平7-101911号公報、特 開平7-97355 号公報に開示されているアリールアミン化 合物類が好ましく、例えば、N,N,N',N'-テトラフェニル -4, 4'-ジアミノフェニル、N, N'- ジフェニル-N, N'-ジ (3-メチルフェニル) -4,4' -ジアミノビフェニル、2,2-【0013】また、特開平2-252793号公報に開示されて 50 ビス (4-ジ-p- トリルアミノフェニル) プロパン、N、N,

Q

N', N'-テトラ-p- トリル-4, 4'-ジアミノビフェニル、ビ ス(4-ジ-p- トリルアミノフェニル)フェニルメタン、 N, N' - ジフェニル-N, N' -ジ (4-メトキシフェニル) -4, 4'-ジアミノビフェニル、N,N,N',N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'- ビス(ジフェ ニルアミノ) クオードリフェニル、4-N、N-ジフェニルア ミノー (2-ジフェニルビニル) ベンゼン、3-メトキシー 4'-N,N-ジフェニルアミノスチルペンゼン、N-フェニル カルパゾール、I, I-ピス (4- ジ-p- トリアミノフェニ フェニル)-4- フェニルシクロヘキサン、ピス (4-ジメ チルアミノ-2- メチルフェニル) - フェニルメタン、N, N, N-トリ (p-トリル) アミン、4- (ジ-p- トリルアミ ノ) -4'- [4 (ジ-p- トリルアミノ) スチリル] スチル ベン、N,N,N',N'-テトラ-p- トリル-4,4'-ジアミノ- ビ フェニル、N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノ-ピフェニルN-フェニルカルバゾール、4.4'- ピス「N-(1-ナフチル) -N- フェニル- アミノ] ピフェニル、4. 4''-ビス [N-(1-ナフチル) -N- フェニル- アミノ] p-ニル- アミノ] ピフェニル、4,4'- ピス [N-(3-アセナ フテニル) -N- フェニル- アミノ] ピフェニル、1,5-ビ ス [N- (1-ナフチル) -N- フェニル- アミノ] ナフタレ ン、4,4'- ピス [N-(9-アントリル) -N- フェニル-ア ミノ] ピフェニル、4,4''-ピス [N-(1-アントリル)-N - フェニル- アミノ] p - ターフェニル、4,4'- ピス [N-(2-フェナントリル) -N- フェニル- アミノ] ピフ ェニル、4,4'- ピス [N-(8-フルオランテニル)-N-フ ェニル- アミノ] ピフェニル、4,4'- ピス [N-(2-ピレ [N-(2-ベリレニル) -N- フェニル- アミノ] ピフェニ ル、4,4'-ビス [N - (1-コロネニル) -N- フェニル-アミノ] ピフェニル、2,6-ピス (ジ-p- トリルアミノ) ナフタレン、2,6-ピス[ジ- (1-ナフチル) アミノ]ナ

チルアミノー2- メチルフェニル) - フェニルメタン、N, N, N-トリ(p-トリル)アミン、4-(ジ-p-トリルアミ ノ)-4'- [4 (ジ-p-トリルアミノ)スチリル] スチル ベン、N, N, N', N'-テトラ-p-トリルー4, 4'-ジアミノービ フェニル、N, N, N', N'-テトラフェニルー4, 4'-ジアミノー ビフェニルト-フェニルカルパゾール、4, 4'- ピス [N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ] ピフェニル、4, 4'- ピス [N-(1-ナフチル)-N-フェニル・アミノ] ピフェニル、4, 4'- ピス [N-(2-ナフチル)-N-フェニル・アミノ] ピフェニル、4, 4'- ピス [N-(3-アセナフテニル)-N-フェニル・アミノ] ピフェニル、7ミノ] ピフェニル、7ミノ] ピフェニル、7ミノ] ピフェニル・アミノ] ナフタレン、4, 4'- ピス [N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ] ピフェニル・アミノ] ナフタレン、4, 4'- ピス [N-(1-アントリル)-N-フェニルーアミノ] ピフェニル・アミノ] ピフェニル・ス・パ・プコントリル)ーN-フェニルーアミノ] ピフェニル・アミノ] ピフェニル・アミノ] ピフェニル・アミノ] ピフェニル・チャンネルアナライザーを使用して定電流駆動し測定した。

【0018】 実施例1

エニル、4,4'- ピス [N-(8-フルオランテニル)-N-フ 図1の積層構成の有機比素子に本発明を適用したものでエニル-アミノ] ピフェニル、4,4'- ピス [N-(2-ピレ ある。ガラス基板1上に陽極透明電極2として、シートニル)-N-フェニル-アミノ] ピフェニル、4,4'- ピス 30 抵抗25Ω/□のITO(インジウム-スズ酸化物三容真空 [N-(2-ペリレニル)-N-フェニル-アミノ] ピフェニ 社製スパッタ蒸着品)がコートされている。その上に正ル、4,4'-ピス [N-(1-コロネニル)-N-フェニル- 孔輸送性を有する下記式:

【化1]

で表される α NPD と塩化第二鉄(FeCl_n)をモル比率1:2の割合で10 ftorrF、共蒸着により3A/砂の蒸浴速度で100Aの厚さに成膜し、正孔注入層3を形成した。

【0019】次に、前記正孔注入層3の上に、正孔輸送 層4としてαNPDを同じ条件で500Åの厚さに真空蒸 50 着して形成した。次に、発光層5として下記式: 【化2】

で表されるトリス(8-キノリノラト)アルミニウム錯体 (以下、Alq と略記する)を同じ条件で700Aの厚さ になるように真空蒸着して形成した。次に陰極となる背 面電極6としてAIを蒸着速度15A/秒で1000A蒸着し た。発光領域は縦0.5cm 、横0.5cm の正方形状とした。 前記の有機LL素子において、陽極電極であるITO 2と陰 極電極であるAl6との間に、直流電圧を印加し、発光 層Alg4からの緑色発光の電圧一輝度、電圧一電流密 度特性を測定した。図2、図3中の丸プロットはそれぞ 20 面図である。 れこの素子の電圧一輝度特性、電圧一電流密度特性を示 すもので、最高4700cd/㎡ の輝度を12V において示 した。このときの電流密度は650mA/cm²であった。ま た、発光開始電圧は3Vであった。

【0020】比較例1

実施例1と同じ条件下、ドーピング層を設けず、170 上 にまず正孔輸送層としてαNPD を500Åの厚さに成膜 し、その上に、発光層としてAlg を正孔輸送層と同じ条 件で700Aの厚さに真空蒸着して形成した。そして、 Alq の上から陰極としてAlを1000A蒸着した。図2、図 30 1 透明基板 3の三角プロットはそれぞれこの素子の電圧一輝度特 性、電圧一電流密度特性を示すものであり、16Vで最 高2400cd/m²の輝度を与えた。このときの電流密度 は110mA/cm²であった。また、発光開始電圧は7 Vで あった。この実験から駆動電圧を下げるのに正孔注入層 3が有効であることが分かる。

[0021] 実施例2

実施例1と同じ条件下、正孔注入層を4000Aの厚膜 にして素子を作成した。図4、図5の丸プロットはそれ ぞれこの素子の電圧一輝度特性、電圧一電流密度特性を 示すもので、実施例1と同じ12Vで最高4500cd/m² の輝度を示した。このときの電流密度は61 OmA/cm'で あった。また、発光開始電圧は3 Vであった。この実験 からドーピングされた正孔注入層は膜厚を厚くしても、 素子の駆動電圧を上昇させない特性を有することが分か 10 った。

10

[0022]

【発明の効果】以上の如く、本発明の有機EL素子は電子 受容性化合物を有機化合物層にドーピングした層を陽極 電極との界面に設けることによって、低駆動電圧素子の 作製を可能にした。したがって、本発明の有機EL素子 は、実用性が高く、表示素子や光源としての有効利用を 期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の積層構造例を示す模式断

【図2】本発明の有機LL素子と比較例の電圧一輝度特性 を示すグラフ図である。

【図3】本発明の有機比素子と比較例の電圧一電流密度 特性を示すグラフ図である。

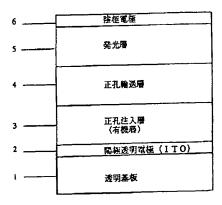
【図4】本発明の有機LL素子と比較例の電圧一輝度特性 を示すグラフ図である。

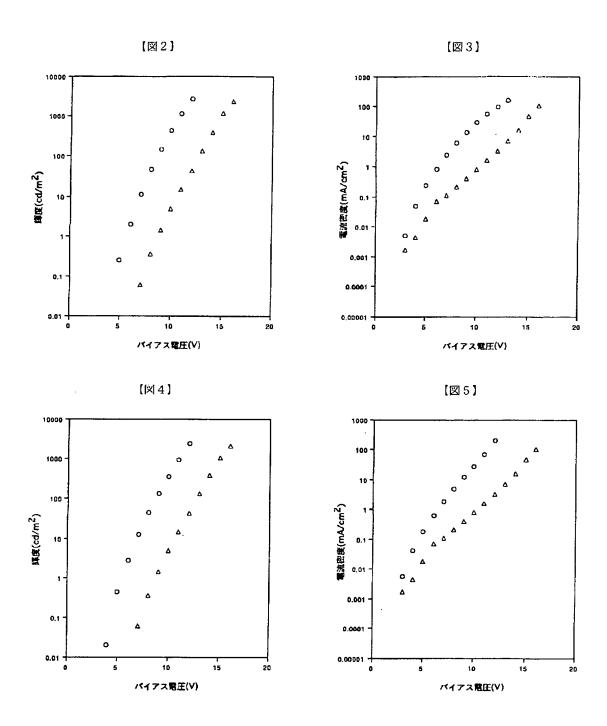
【図5】本発明の有機比素子と比較例の電圧一電流密度 特性を示すグラフ図である。

【符号の説明】

- - 2 陽極透明電極
 - 3 正孔注入層
 - 4 正孔輸送層
 - 5 発光層
 - 6 陰極電極

【図1】





フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 潤 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア イメス内

